

昭 56 2.25 発行

特許法第17条の2の規定による補正の掲載

昭和 53 年特許願第 107380 号(特開昭
55-34258 号 昭和 55 年 2 月 10 日
発行公開特許公報 55-343 号掲載)につ
いては特許法第17条の2の規定による補正があっ
たので下記のとおり掲載する。

Int. Cl.	識別 記号	庁内整理番号
C09D 3/82		7167 4J
C08G 77/02		7167 4J

8.補正の内容

- (1) 特許請求の範囲を別紙のとおり訂正します。
- (2) 明細書第 6 ページ第 9 行目の「、クロル酢酸、フルオール酢酸」を削除します。
- (3) 同第 10 ページ第 8 行目の「 H_3BO_3 、 $(RO)_3B$ 」を「 H_3BO_3 、 $(RO)_2B$ 」に訂正します。
- (4) 同第 13 ページ末行の「半導体用ドーブオキシド」を「半導体用ドーブドオキサイド」に訂正します。
- (5) 同第 23 ページ第 9 行目の「沸酸」を「フッ酸」に訂正します。

手 続 補 正 書

昭和 55 年 1 月 10 日

特許庁長官 島 田 春 樹 殿
特許審判長
特許審査官

2 日 印

1. 事件の表示

昭和 53 年 特許願 第 107380 号

2. 発明の名称

シリカ系被膜用塗布液

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 神奈川県川崎市中原区中丸子 251 番地

氏 名 東京電子化学株式会社

代表者 伊 藤 毅 雄

4. 代 理 人

〒 104 東京都中央区銀座 6 丁目 4 番 5 号 土曜ビル 5 階

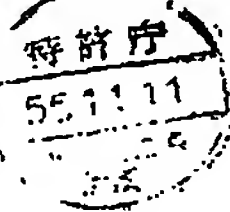
(7182) 弁 理 士 阿 形 明

電 話 (571) 9920 番

5. 補正命令の日付 自 発

6. 補正により増加する発明の数 0

7. 補正の対象 明細書の特許請求の範囲の欄
及び発明の詳細な説明の欄



特許請求の範囲

1. アルコキシシランと低級カルボン酸とアルコールの混合物を、有機酸系反応促進剤の存在下で反応させて得た反応生成物からなるシリカ系被膜用塗布液。
2. 有機酸系反応促進剤が、原料として用いられる低級カルボン酸よりも小さい解離指数をもつ有機カルボン酸である特許請求の範囲第 1 項記載のシリカ系被膜用塗布液。
3. 有機酸系反応促進剤の有機カルボン酸がギ酸、シュウ酸、クエン酸、マロン酸、サリチル酸ピクリン酸、フタル酸又はマレイン酸である特許請求の範囲第 2 項記載のシリカ系被膜用塗布液。
4. 有機酸系反応促進剤が有機スルホン酸である特許請求の範囲第 1 項記載のシリカ系被膜用塗布液。
5. 有機スルホン酸がベンゼンスルホン酸、トルエンスルホン酸又はナフタリンスルホン酸である特許請求の範囲第 4 項記載のシリカ系被膜用塗布液。

6. 反応生成物にガラス質形成剤又は有機高分子膜形成剤を添加してなる特許請求の範囲第1項記載のシリカ系被膜用塗布液。

7. アルコキシシランとカルボン酸とアルコールの混合物に有機酸系反応促進剤を加え、反応液中のアルコキシシラン及びカルボン酸の含有量がそれぞれ当初の20重量%以下になるまで反応させることを特徴とするシリカ系被膜用塗布液の製造方法。

8. アルコキシシランとカルボン酸とアルコールの混合物を、有機酸系反応促進剤の存在下で反応させて得た反応混合物を、基体上に塗布し、熱処理することからなるシリカ系被膜の形成方法。